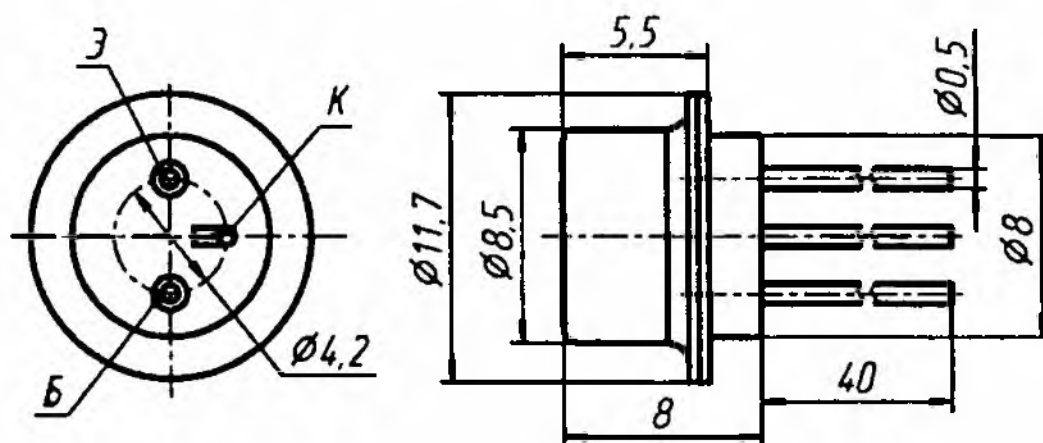


КТ605А, КТ605Б, КТ605АМ, КТ605БМ

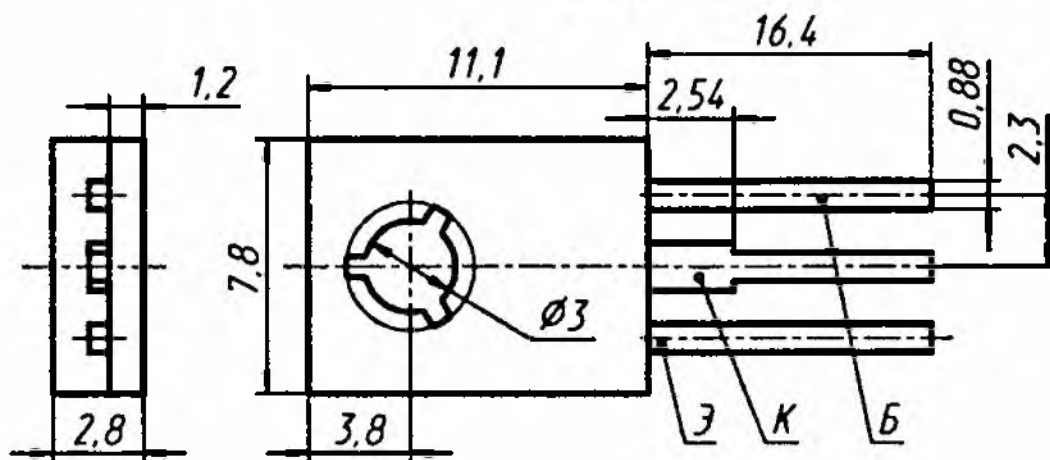
Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры *n-p-n*. Предназначены для применения в усилителях, импульсных и переключающих высокочастотных устройствах. Выпускаются в металlostеклянном (КТ605А, КТ605Б) с гибкими выводами и пластмассовом (КТ605АМ, КТ605БМ) корпусах с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора в металlostеклянном корпусе не более 2 г, в пластмассовом — не более 1 г.

КТ605(А,Б)



КТ605(АМ,БМ)



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока
в схеме ОЭ при $I_3 = 20$ мА, $U_{кб} = 40$ В:

КТ605А, КТ605АМ	10...40
КТ605Б, КТ605БМ	30...120

Граничная частота коэффициента передачи
тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 40$ В, $I_3 = 20$ мА,
не менее

40 МГц

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер
при $I_k = 20$ мА, $I_b = 2$ мА, не более

8 В

Емкость коллекторного перехода
при $U_{кб} = 40$ В, $f = 2$ МГц, не более

7 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0$,
 $f = 2$ МГц, не более

50 пФ

Обратный ток коллектор—эмиттер
при $U_{кз} = 250$ В, не более

20 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{эб0} = 5$ В,
не более

50 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:

при $T = +100$ °С

300 В

при $T = +150$ °С

150 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер
при $R_{бз} = 1$ кОм:

при $T = +100$ °С

250 В

при $T = +150$ °С

125 В

Постоянное напряжение эмиттер—база:

при $T = +100$ °С

5 В

при $T = +150$ °С

2,5 В

Постоянный ток коллектора

100 мА

Импульсный ток коллектора

200 мА

Постоянная рассеиваемая мощность:

$T = +25$ °С

0,4 Вт

$T = +100$ °С

0,17 Вт

Тепловое сопротивление переход—среда

300 °С/Вт

Температура р-п перехода

+150 °С

Температура окружающей среды и корпуса

−40...+150 °С

Изгиб выводов допускается под углом не более 90° в плоскости, перпендикулярной плоскости основания корпуса, и не ближе 3 мм от корпуса транзистора с радиусом изгиба не менее 1,5 мм.

При установке транзистора на печатную плату с шагом координатной сетки 2,5 мм допускается одноразовая формовка выводов с их разводкой для совмещения с монтажными отверстиями (контактами).

При изгибе и формовке выводов необходимо применять специальные шаблоны, а также обеспечивать неподвижность выводов между местом изгиба и корпусом транзистора. Кручение выводов вокруг оси не допускается.

Пайка выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора в течение не более 5 с. Температура паяльника не должна превышать $+260^\circ\text{C}$. При пайке должен быть обеспечен надежный теплоотвод между местом пайки и корпусом транзистора.